

**Silizium-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren  
höherer Sperrspannungen für allgemeine  
Anwendungen****Bauform 3****Wärmewiderstand  $R_{thja} \leq 0,5 \text{ K/mW}$** **Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich**

	SS 200	SS 201	SS 202
$U_{CBO}, U_{CEV}$ (bei $-U_{BE} = 1 \text{ V}$ )	70 V	100 V	120 V
$U_{EB0}$		5 V	
$I_C$		30 mA	
$I_B$		10 mA	
$P_{tot}$ (bei $\vartheta_a \leq 25^\circ\text{C}$ )		150 mW	
$\vartheta_j$		100 °C	
$\vartheta_a$		-40 ... +85 °C	

**Statische Kennwerte ( $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$ )**

$I_{CEV}$ (bei $U_{CE} = U_{CEV}, -U_{BE} = 1 \text{ V}$ )	$\leq 1 \mu\text{A}$
$I_{EB0}$ (bei $U_{EB} = 5 \text{ V}$ )	$100 \text{ nA}$
$U_{CEsat}$ (bei $I_C = 1 \text{ mA}, I_B = 31 \mu\text{A}$ )	$0,6 \text{ V}$
$h_{21E}$ (bei $U_{CE} = 3 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}$ )	32